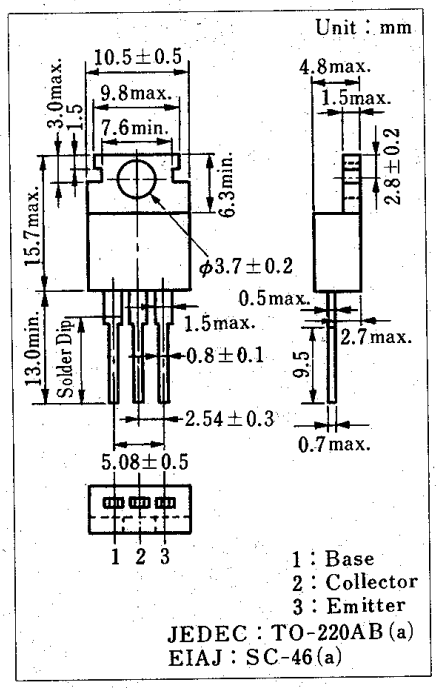
2SB750, 2SB750A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形ダーリントン
Si PNP Epitaxial Planar Darlington

電力増幅用，スイッチング用／Power Amplifier, Switching
2SD836, 2SD836A とコンプリメンタリ／Complementary Pair with 2SD836, 2SD836A



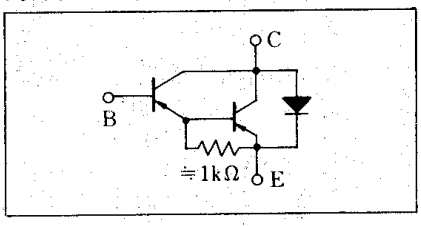
■ 特　徴／Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。／High h_{FE}
- スイッチング速度が速い。／High speed switching

■ 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25 ℃)

Item		Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SB750	V_{CBO}	−60	V
	2SB750A		−80	
コレクタ・エミッタ電圧	2SB750	V_{CEO}	−60	V
	2SB750A		−80	
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	−5	V
せん頭コレクタ電流		I_{CP}	−4	A
コレクタ電流		I_C	−2	A
コレクタ損失 (Tc=25℃)		P_C	35	W
接合部温度		T_j	150	℃
保存温度		T_{stg}	−55～+150	℃

内部接続図／Connection Diagram



■ 電気的特性／Electrical Characteristics (Tc=25°C)

Item		Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	2SB750	I_{CBO}	V_{CB}=−60V, I_E=0			−1	mA
	2SB750A		V_{CB}=−80 V, I_E=0			−1	
コレクタしゃ断電流	2SB750	I_{CEO}	V_{CB}=−30 V, I_B=0			−2	mA
	2SB750A		V_{CB}=−40 V, I_B=0			−2	
エミッタしゃ断電流		I_{EBO}	V_{EB}=−5 V, I_C=0			−2	mA
コレクタ・エミッタ電圧	2SB750	V_{CEO}	I_C=−30 mA, I_B=0	−60			V
	2SB750A		I_C=−30 mA, I_B=0	−80			V
直流電流増幅率		h_{FE1}	V_{CE}=−4 V, I_C=−1 A	1000			
		h_{FE2}*	V_{CE}=−4 V, I_C=−2 A	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	V_{CE}=−4 V, I_C=−2 A			−2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	I_C=−2 A, I_B=−8 mA			−2.5	V
ターンオン時間		t_{on}	I_C=−2 A, I_{B1}=−8mA, I_{B2}=8mA		0.2		μs
ターンオフ時間		t_{off}			2		μs

*h_{FE2} ランク分類／h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	1000～2500	2000～5000	4000～10000